

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2016 年 8 月 25 日(25.08.2016)



(10) 国際公開番号

WO 2016/132722 A1

- (51) 国際特許分類:
C08F 212/06 (2006.01) *G03F 7/039* (2006.01)
C08F 220/22 (2006.01) *G03F 7/20* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2016/000767
- (22) 国際出願日: 2016 年 2 月 15 日(15.02.2016)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2015-031720 2015 年 2 月 20 日(20.02.2015) JP
- (71) 出願人: 日本ゼオン株式会社(ZEON CORPORATION) [JP/JP]; 〒1008246 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 星野 学(HOSHINO, Manabu); 〒1008246 東京都千代田区丸の内一丁目 6 番 2 号 日本ゼオン株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 杉村 憲司(SUGIMURA, Kenji); 〒1000013 東京都千代田区霞が関三丁目 2 番 1 号 霞が関コモンゲート西館 3 6 階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

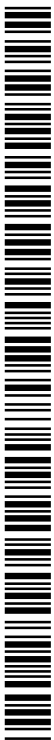
— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))

(54) Title: POLYMER AND POSITIVE RESIST COMPOSITION

(54) 発明の名称: 重合体およびポジ型レジスト組成物

(57) Abstract: The purpose of the present invention is to provide a polymer which can be satisfactorily used as a positive resist which has a low film reduction rate in a state of low ionized or other irradiation, and to provide a positive resist composition which can satisfactorily form a high-resolution pattern. The polymer contains an α -methylstyrene unit and an α -chloro-methyl acrylate unit, and the proportion of components of a molecular weight of less than 6000 is 0.5% or less. This positive resist composition contains the aforementioned polymer and a solvent.

(57) 要約: 本発明は、電離放射線等の照射量が少ない状態での減膜率が低いポジ型レジストとして良好に使用し得る重合体、および、高解像度のパターンを良好に形成し得るポジ型レジスト組成物を提供することを目的とする。本発明の重合体は、 α -メチルスチレン単位と、 α -クロロアクリル酸メチル単位とを含有し、分子量が6000未満の成分の割合が0.5%以下である。また、本発明のポジ型レジスト組成物は、上述の重合体と、溶剤とを含む。



WO 2016/132722 A1

明 細 書

発明の名称：重合体およびポジ型レジスト組成物

技術分野

[0001] 本発明は、重合体およびポジ型レジスト組成物に関し、特に、ポジ型レジストとして好適に使用し得る重合体および当該重合体を含むポジ型レジスト組成物に関するものである。

背景技術

[0002] 従来、半導体製造等の分野において、電子線などの電離放射線や紫外線などの短波長の光（以下、電離放射線と短波長の光とを合わせて「電離放射線等」と称することがある。）の照射により主鎖が切断されて現像液に対する溶解性が増大する重合体が、主鎖切断型のポジ型レジストとして使用されている。

[0003] そして、例えば特許文献1には、高感度な主鎖切断型のポジ型レジストとして、 α -メチルスチレン単位と α -クロロアクリル酸メチル単位とを含有する α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体よりなるポジ型レジストが開示されている。

先行技術文献

特許文献

[0004] 特許文献1：特公平8-3636号公報

発明の概要

発明が解決しようとする課題

[0005] 主鎖切断型のポジ型レジストを用いて得られるパターンをより微細化し解像度を高めるためには、電離放射線等の照射により主鎖を切断し現像液に溶解させる部分と、溶解させずに残す部分とをできるだけ鮮明に区別できるレジストが求められる。ここで、より微細なパターンを形成する観点からは、溶解させずに残すレジスト部分のトップの崩れを少なくすべく、溶解させるレジスト部分が十分に溶解可能となるまでに曝される照射量より少ない照

射量では、現像液に対する溶解性が低いレジストが好ましい。かかるレジストには、電離放射線等の照射量が少ない状態での減膜率（低照射量における減膜率）を低下させることが求められている。

[0006] しかし、特許文献1に記載の α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体よりなるポジ型レジストは、電離放射線等の照射量が少ない状態において過度に減膜してしまうという問題があった。そのため、特許文献1に記載の α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体よりなるポジ型レジストには、電離放射線等の照射量が少ない状態での減膜率を更に低下させるという点において改善の余地があった。

[0007] そこで、本発明は、電離放射線等の照射量が少ない状態での減膜率が低いポジ型レジストとして良好に使用し得る重合体を提供することを目的とする。

また、本発明は、高解像度のパターンを良好に形成し得るポジ型レジスト組成物を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

[0008] 本発明者は、上記目的を達成するために鋭意検討を行った。そして、本発明者は、分子量が6000未満の成分の割合が所定の値以下である α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体が、電離放射線等の照射量が少ない状態での減膜率が低いポジ型レジストとして良好に使用し得ることを見出し、本発明を完成させた。

[0009] 即ち、この発明は、上記課題を有利に解決することを目的とするものであり、本発明の重合体は、 α -メチルスチレン単位と、 α -クロロアクリル酸メチル単位とを含有し、分子量が6000未満の成分の割合が0.5%以下であることを特徴とする。分子量が6000未満の成分の割合が0.5%以下の α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体は、ポジ型レジストとして使用した際の低照射量における減膜率が低く、ポジ型レジストとして良好に使用することができる。

なお、本発明において、「分子量が6000未満の成分の割合」は、ゲル

浸透クロマトグラフィーによって得られるクロマトグラムを使用し、クロマトグラム中のピークの総面積（A）に対するクロマトグラム中の分子量が6000未満の成分のピークの面積の合計（C）の割合（ $= (C/A) \times 100\%$ ）を算出することにより求めることができる。

[0010] ここで、本発明の重合体は、分子量が10000未満の成分の割合が0.5%以下であることが好ましい。分子量が10000未満の成分の割合が0.5%以下であれば、ポジ型レジストとして使用した際の低照射量における減膜率を更に低下させることができるからである。

なお、本発明において、「分子量が10000未満の成分の割合」は、ゲル浸透クロマトグラフィーによって得られるクロマトグラムを使用し、クロマトグラム中のピークの総面積（A）に対するクロマトグラム中の分子量が10000未満の成分のピークの面積の合計（B）の割合（ $= (B/A) \times 100\%$ ）を算出することにより求めることができる。

[0011] そして、本発明の重合体は、分子量が80000超の成分の割合が15%以上であることが好ましい。分子量が80000超の成分の割合が15%以上であれば、ポジ型レジストとして使用した際の低照射量における減膜率を更に低下させることができるからである。

[0012] 更に、本発明の重合体は、重量平均分子量（Mw）が55000以上であることが好ましい。重量平均分子量（Mw）が55000以上であれば、ポジ型レジストとして使用した際の低照射量における減膜率を更に低下させることができるからである。

なお、本発明において、「重量平均分子量（Mw）」は、ゲル浸透クロマトグラフィーを用いて測定することができる。

[0013] また、この発明は、上記課題を有利に解決することを目的とするものであり、本発明のポジ型レジスト組成物は、上述した重合体の何れかと、溶剤とを含むことを特徴とする。上述した重合体をポジ型レジストとして含有すれば、トップの崩れが少なく高解像度のパターンを良好に形成することができる。

発明の効果

[0014] 本発明の重合体によれば、電離放射線等の照射量が少ない状態での減膜率が低いポジ型レジストを提供することができる。

また、本発明のポジ型レジスト組成物によれば、高解像度のパターンを良好に形成することができる。

発明を実施するための形態

[0015] 以下、本発明の実施形態について詳細に説明する。

ここで、本発明の重合体は、電子線などの電離放射線や紫外線などの短波長の光の照射により主鎖が切断されて低分子量化する、主鎖切断型のポジ型レジストとして良好に使用することができる。そして、本発明のポジ型レジスト組成物は、ポジ型レジストとして本発明の重合体を含むものである。

[0016] (重合体)

本発明の重合体は、 α -メチルスチレン単位と、 α -クロロアクリル酸メチル単位とを含有する α -メチルスチレン・ α -クロロアクリル酸メチル共重合体であり、分子量が6000未満の成分の割合が0.5%以下であることを特徴とする。そして、本発明の重合体は、 α 位にクロロ基(-Cl)を有する α -クロロアクリル酸メチルに由来する構造単位(α -クロロアクリル酸メチル単位)を含んでいるので、電離放射線等(例えば、電子線、KrFレーザー、ArFレーザー、EUVレーザーなど)が照射されると、主鎖が容易に切断されて低分子量化する。また、本発明の重合体は、分子量が6000未満の成分の割合が0.5%以下であるので、ポジ型レジストとして使用した際の低照射量における減膜率が低く、主鎖切断型のポジ型レジストとして良好に使用することができる。

[0017] < α -メチルスチレン単位>

ここで、 α -メチルスチレン単位は、 α -メチルスチレンに由来する構造単位である。そして、本発明の重合体は、 α -メチルスチレン単位を有しているので、ポジ型レジストとして使用した際に、ベンゼン環の保護安定性により優れた耐ドライエッチング性を発揮する。

なお、本発明の重合体は、 α -メチルスチレン単位を30mol%以上70mol%以下の割合で含有することが好ましい。

[0018] < α -クロロアクリル酸メチル単位>

また、 α -クロロアクリル酸メチル単位は、 α -クロロアクリル酸メチルに由来する構造単位である。そして、本発明の重合体は、 α -クロロアクリル酸メチル単位を有しているので、電離放射線等が照射されると、塩素原子が脱離し、 β 開裂反応によって主鎖が容易に切断される。従って、本発明の重合体よりなるポジ型レジストは、高い感度を示す。

なお、本発明の重合体は、 α -クロロアクリル酸メチル単位を30mol%以上70mol%以下の割合で含有することが好ましい。

[0019] <分子量が6000未満の成分の割合>

本発明の重合体は、分子量が6000未満の成分の割合が、0.5%以下であることが必要であり、0.15%以下であることがより好ましく、0.1%以下であることが更に好ましい。分子量が6000未満の成分の割合が0.5%超の場合、ポジ型レジストとして使用した際の低照射量における減膜率を十分に低下させることができない。また、分子量が6000未満の成分の割合が0.15%以下であれば、低照射量における減膜率を更に低下することが可能となるのみならず、ポジ型レジストとして使用した際の γ 値を高めることができる。

なお、 γ 値は、電離放射線等の照射量の常用対数と、現像後のレジストの残膜厚との関係を示す感度曲線の傾きの大きさを表し、 γ 値を高めることで、解像度のより高いパターンを得ることが可能となる。

[0020] <分子量が10000未満の成分の割合>

そして、本発明の重合体は、分子量が10000未満の成分の割合が0.5%以下であることが好ましく、0.3%以下であることがより好ましい。分子量が10000未満の成分の割合が0.5%以下であれば、ポジ型レジストとして使用した際の低照射量における減膜率を更に低下させることができる。

[0021] ＜分子量が80000超の成分の割合＞

ここで、本発明の重合体は、分子量が80000超の成分の割合が、15%以上であることが好ましく、20%以上であることがより好ましく、40%以下であることが好ましい。分子量が80000超の成分の割合が15%以上であれば、低照射量における減膜率を更に低下させることができ、40%以下であれば、感度などの特性に優れるポジ型レジストとして良好に使用し得る。

[0022] ＜分子量が100000超の成分の割合＞

また、本発明の重合体は、分子量が100000超の成分の割合が、7%以上であることが好ましく、10%以上であることがより好ましく、30%以下であることが好ましく、25%以下であることがより好ましい。分子量が100000超の成分の割合が7%以上であれば、低照射量における減膜率を更に低下させることができ、30%以下であれば、感度などの特性に優れるポジ型レジストとして良好に使用し得る。

なお、本発明において、「分子量が100000超の成分の割合」は、ゲル浸透クロマトグラフィーによって得られるクロマトグラムを使用し、クロマトグラム中のピークの総面積（A）に対するクロマトグラム中の分子量が100000超の成分のピークの面積の合計（E）の割合（ $= (E / A) \times 100\%$ ）を算出することにより求めることができる。

[0023] ＜重量平均分子量＞

本発明の重合体の重量平均分子量（ M_w ）は、36000以上であることが好ましく、55000以上であることがより好ましく、60000以上であることが更に好ましく、100000以下であることが好ましく、70000以下であることがより好ましい。重合体の重量平均分子量（ M_w ）が36000以上であれば、低照射量における減膜率を更に低下させることができ、100000以下であれば、感度などの特性に優れるポジ型レジストとして良好に使用し得る。

[0024] ＜数平均分子量＞

また、本発明の重合体の数平均分子量 (M_n) は、25000以上であることが好ましく、30000以上であることがより好ましく、42000以上であることが更に好ましく、100000以下であることが好ましく、50000以下であることがより好ましい。重合体の数平均分子量 (M_n) が25000以上であれば、低照射量における減膜率を更に低下させることができ、100000以下であれば、感度などの特性に優れるポジ型レジストとして良好に使用し得る。

なお、本発明において「数平均分子量 (M_n)」は、ゲル浸透クロマトグラフィーを用いて測定することができる。

[0025] <分子量分布>

そして、本発明の重合体の分子量分布 (M_w/M_n) は、1.48未満であることが好ましく、1.47以下であることがより好ましく、1.20以上であることが好ましく、1.24以上であることがより好ましく、1.27以上であることが更に好ましい。重合体の分子量分布 (M_w/M_n) が1.48未満であれば、 γ 値などの特性に優れるポジ型レジストとして良好に使用し得り、1.20以上であれば、重合体の調製が容易となる。

なお、本発明において、「分子量分布 (M_w/M_n)」とは、数平均分子量 (M_n) に対する重量平均分子量 (M_w) の比を指す。

[0026] (重合体の調製方法)

そして、上述した性状を有する重合体は、例えば、 α -メチルスチレンと α -クロロアクリル酸メチルとを含む単量体組成物を重合させた後、得られた重合物を精製することにより調製することができる。

なお、重合体の組成、分子量分布、重量平均分子量および数平均分子量、並びに、重合体中の各分子量の成分の割合は、重合条件および精製条件を変更することにより調整することができる。具体的には、例えば、重量平均分子量および数平均分子量は、重合温度を高くすれば、小さくすることができる。また、重量平均分子量および数平均分子量は、重合時間を短くすれば、小さくすることができる。

[0027] <単量体組成物の重合>

ここで、本発明の重合体の調製に用いる単量体組成物としては、 α -メチルスチレンおよび α -クロロアクリル酸メチルを含む単量体と、溶媒と、重合開始剤と、任意に添加される添加剤との混合物を用いることができる。そして、単量体組成物の重合は、既知の方法を用いて行うことができる。中でも、溶媒としては、シクロペンタノンなどを用いることが好ましく、重合開始剤としては、アゾビスイソブチロニトリルなどのラジカル重合開始剤を用いることが好ましい。

[0028] なお、重合体の組成は、重合に使用した単量体組成物中の各単量体の含有割合を変更することにより調整することができる。また、重合体中に含まれている分子量が高い成分の割合は、重合開始剤の量を変更することにより調整することができ、例えば重合開始剤の量を少なくすれば、分子量が高い成分の割合を増加させることができる。

[0029] そして、単量体組成物を重合して得られた重合物は、特に限定されることなく、重合物を含む溶液にテトラヒドロフラン等の良溶媒を添加した後、良溶媒を添加した溶液をメタノール等の貧溶媒中に滴下して重合物を凝固させることにより回収し、以下のようにして精製することができる。

[0030] <重合物の精製>

得られた重合物を精製して上述した性状を有する重合体を得る際に用いる精製方法としては、特に限定されることなく、再沈殿法やカラムクロマトグラフィー法などの既知の精製方法を用いることができる。中でも、精製方法としては、再沈殿法を用いることが好ましい。

なお、重合物の精製は、複数回繰り返して実施してもよい。

[0031] そして、再沈殿法による重合物の精製は、例えば、得られた重合物をテトラヒドロフラン等の良溶媒に溶解した後、得られた溶液を、テトラヒドロフラン等の良溶媒とメタノール等の貧溶媒との混合溶媒に滴下し、重合物の一部を析出させることにより行うことが好ましい。このように、良溶媒と貧溶媒との混合溶媒中に重合物の溶液を滴下して重合物の精製を行えば、良溶媒

および貧溶媒の種類や混合比率を変更することにより、得られる重合体の分子量分布、重量平均分子量、数平均分子量および分子量が低い成分の割合を容易に調整することができる。具体的には、例えば、混合溶媒中の良溶媒の割合を高めるほど、混合溶媒中で析出する重合体の分子量を大きくすることができる。

[0032] なお、再沈殿法により重合物を精製する場合、本発明の重合体としては、所望の性状を満たせば、良溶媒と貧溶媒との混合溶媒中で析出した重合体を用いてもよいし、混合溶媒中で析出しなかった重合体（即ち、混合溶媒中に溶解している重合体）を用いてもよい。ここで、混合溶媒中で析出しなかった重合体は、濃縮乾固などの既知の手法を用いて混合溶媒中から回収することができる。

[0033] （ポジ型レジスト組成物）

本発明のポジ型レジスト組成物は、上述した重合体と、溶剤とを含み、任意に、レジスト組成物に配合され得る既知の添加剤を更に含有する。そして、本発明のポジ型レジスト組成物は、上述した重合体をポジ型レジストとして含有しているので、本発明のポジ型レジスト組成物を塗布および乾燥させて得られるレジスト膜を使用すれば、高解像度のパターンを良好に形成することができる。

[0034] ＜溶剤＞

なお、溶剤としては、上述した重合体を溶解可能な溶剤であれば既知の溶剤を用いることができる。中でも、適度な粘度のポジ型レジスト組成物を得てポジ型レジスト組成物の塗工性を向上させる観点からは、溶剤としてはアニソールを用いることが好ましい。

実施例

[0035] 以下、本発明について実施例に基づき具体的に説明するが、本発明はこれら実施例に限定されるものではない。なお、以下の説明において、量を表す「%」および「部」は、特に断らない限り、質量基準である。

そして、実施例および比較例において、重合体の重量平均分子量、数平均

分子量および分子量分布、重合体中の各分子量の成分の割合、並びに、重合体よりなるポジ型レジストの低照射量における減膜率および γ 値は、下記の方法で測定および評価した。

[0036] <重量平均分子量、数平均分子量および分子量分布>

得られた重合体についてゲル浸透クロマトグラフィーを用いて重量平均分子量 (M_w) および数平均分子量 (M_n) を測定し、分子量分布 (M_w/M_n) を算出した。

具体的には、ゲル浸透クロマトグラフ (東ソー製、HLC-8220) を使用し、展開溶媒としてテトラヒドロフランを用いて、重合体の重量平均分子量 (M_w) および数平均分子量 (M_n) を標準ポリスチレン換算値として求めた。そして、分子量分布 (M_w/M_n) を算出した。

<重合体中の各分子量の成分の割合>

ゲル浸透クロマトグラフ (東ソー製、HLC-8220) を使用し、展開溶媒としてテトラヒドロフランを用いて、重合体のクロマトグラフを得た。そして、得られたクロマトグラムから、ピークの総面積 (A)、分子量が10000未満の成分のピークの面積の合計 (B)、分子量が6000未満の成分のピークの面積の合計 (C)、分子量が80000超の成分のピークの面積の合計 (D) および分子量が100000超の成分のピークの面積の合計 (E) を求めた。そして、下記式を用いて各分子量の成分の割合を算出した。

$$\text{分子量が10000未満の成分の割合 (\%)} = (B/A) \times 100$$

$$\text{分子量が6000未満の成分の割合 (\%)} = (C/A) \times 100$$

$$\text{分子量が80000超の成分の割合 (\%)} = (D/A) \times 100$$

$$\text{分子量が100000超の成分の割合 (\%)} = (E/A) \times 100$$

<低照射量における減膜率>

スピンコーター (ミカサ製、MS-A150) を使用し、ポジ型レジスト組成物を直径4インチのシリコンウェハ上に厚さ500nmになるように塗布した。そして、塗布したポジ型レジスト組成物を温度180℃のホットプレ

ートで3分間加熱して、シリコンウェハ上にレジスト膜を形成し、得られたレジスト膜の初期厚み T_0 を光学式膜厚計（大日本スクリーン製、ラムダエース）で測定した。そして、電子線描画装置（エリオニクス社製、ELS-5700）を用いて、レジスト膜上に照射量 $16\mu\text{C}/\text{cm}^2$ でパターンを描画し、レジスト用現像液として酢酸アミル（日本ゼオン社製、ZED-N50）を用いて温度 23°C で1分間の現像処理を行った後、イソプロピルアルコールで10秒間リンスした。次に、描画した部分のレジスト膜の厚み T_1 を上記の光学式膜厚計で測定した。そして、低照射量における減膜率（ $0 \leq \text{減膜率} \leq 1.00$ ）を、以下の計算式により算出し、以下の基準に従って評価した。低照射量における減膜率の値が小さいほど、トップの崩れが少なく、高解像度のパターンを良好に形成し得ることを示す。

$$\text{低照射量における減膜率} = \{ (T_0 - T_1) / T_0 \}$$

A：低照射量における減膜率が0.004以下

B：低照射量における減膜率が0.004超0.007以下

C：低照射量における減膜率が0.007超0.011以下

D：低照射量における減膜率が0.011超

< γ 値>

「低照射量における減膜率」の評価と同様にして、シリコンウェハ上にレジスト膜を形成した。そして、電子線描画装置（エリオニクス社製、ELS-5700）を用いて、電子線の照射量が互いに異なるパターン（寸法 $500\mu\text{m} \times 500\mu\text{m}$ ）をレジスト膜上に複数描画し、レジスト用現像液として酢酸アミル（日本ゼオン社製、ZED-N50）を用いて温度 23°C で1分間の現像処理を行った後、イソプロピルアルコールで10秒間リンスした。なお、電子線の照射量は、 $4\mu\text{C}$ から $152\mu\text{C}$ の範囲内で $4\mu\text{C}$ ずつ異ならせた。次に、描画した部分のレジスト膜の厚みを光学式膜厚計（大日本スクリーン製、ラムダエース）で測定し、電子線の総照射量の常用対数と、現像後のレジスト膜の残膜率（＝（現像後のレジスト膜の膜厚／シリコンウェハ上に形成したレジスト膜の膜厚））との関係を示す感度曲線を作成した。

そして、得られた感度曲線（横軸：電子線の総照射量の常用対数、縦軸：レジスト膜の残膜率（ $0 \leq \text{残膜率} \leq 1.00$ ））について、下記の式を用いて γ 値を求めた。なお、下記の式中、 E_0 は、残膜率 $0.20 \sim 0.80$ の範囲において感度曲線を二次関数にフィッティングし、得られた二次関数（残膜率と総照射量の常用対数との関数）に対して残膜率 0 を代入した際に得られる総照射量の対数である。また、 E_1 は、得られた二次関数上の残膜率 0 の点と残膜率 0.50 の点とを結ぶ直線（感度曲線の傾きの近似線）を作成し、得られた直線（残膜率と総照射量の常用対数との関数）に対して残膜率 1.00 を代入した際に得られる総照射量の対数である。そして、下記式は、残膜率 0 と 1.00 との間での上記直線の傾きを表している。

[数1]

$$\gamma = \left| \log_{10} \left(\frac{E_1}{E_0} \right) \right|^{-1}$$

そして、以下の基準に従って評価した。 γ 値の値が大きいほど、感度曲線の傾きが大きく、高解像度のパターンを良好に形成し得ることを示す。

- A : γ 値が 9.5 以上
- B : γ 値が 8.5 以上 9.5 未満
- C : γ 値が 7.5 以上 8.5 未満
- D : γ 値が 7.5 未満

[0037]（実施例1）

<重合体の調製>

[単量体組成物の重合]

単量体としての α -クロロアクリル酸メチル 3.0 g および α -メチルスチレン 6.88 g と、溶媒としてのシクロペンタノン 2.47 g と、重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリル 0.02182 g とを含む単量体組成物をガラス容器に入れ、ガラス容器を密閉および窒素置換して、窒素雰囲気下、 78°C の恒温槽内で 6.5 時間攪拌した。その後、室温に戻し、ガラス容器内を大気解放した後、得られた溶液にテトラヒドロフラン（THF

）30gを加えた。そして、THFを加えた溶液をメタノール300g中に滴下し、重合物を析出させた。その後、析出した重合物を含む溶液をキリヤマ漏斗によりろ過し、白色の凝固物（重合物）を得た。得られた重合物の重量平均分子量（ M_w ）は35000であり、分子量分布（ M_w/M_n ）は1.60であった。また、得られた重合物は、 α -メチルスチレン単位と α -クロロアクリル酸メチル単位とを50mol%ずつ含んでいた。

[重合物の精製]

次いで、得られた重合物を100gのTHFに溶解させ、得られた溶液をTHF600gとメタノール（MeOH）400gとの混合溶媒に滴下し、白色の凝固物（ α -メチルスチレン単位および α -クロロアクリル酸メチル単位を含有する重合体）を析出させた。その後、析出した重合体を含む溶液をキリヤマ漏斗によりろ過し、白色の重合体を得た。そして、得られた重合体について、重量平均分子量、数平均分子量および分子量分布、重合体中の各分子量の成分の割合を測定した。結果を表1に示す。

<ポジ型レジスト組成物の調製>

得られた重合体を溶剤としてのアニソールに溶解させ、重合体の濃度が11質量%であるレジスト溶液（ポジ型レジスト組成物）を調製した。そして、重合体よりなるポジ型レジストの低照射量における減膜率および γ 値を評価した。結果を表1に示す。

[0038]（実施例2）

重合物の精製時に混合溶媒としてTHF550gとMeOH450gとの混合溶媒を用いた以外は実施例1と同様にして、重合物、重合体およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例1と同様にして測定および評価を行った。結果を表1に示す。

[0039]（実施例3）

単量体組成物の重合時に使用する重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を0.03273gに変更し、重合物の精製時に混合溶媒としてTHF550gとMeOH450gとの混合溶媒を用いた以外は実施例1

と同様にして、重合物、重合体およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして測定および評価を行った。結果を表 1 に示す。

なお、精製前の重合物の重量平均分子量 (M_w) は 29000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.56 であった。

[0040] (実施例 4)

単量体組成物の重合時に使用する重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.04364 g に変更し、重合物の精製時に混合溶媒として THF 550 g と MeOH 450 g との混合溶媒を用いた以外は実施例 1 と同様にして、重合物、重合体およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして測定および評価を行った。結果を表 1 に示す。

なお、精製前の重合物の重量平均分子量 (M_w) は 24000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.53 であった。

[0041] (実施例 5)

単量体組成物の重合時に使用する重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.01091 g に変更した以外は実施例 1 と同様にして、重合物、重合体およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして測定および評価を行った。結果を表 1 に示す。

なお、精製前の重合物の重量平均分子量 (M_w) は 55000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.85 であった。

[0042] (実施例 6)

<重合体の調製>

[単量体組成物の重合]

重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.01091 g に変更した以外は実施例 1 と同様にして単量体組成物を重合し、重合物を得た。なお、重合物の重量平均分子量 (M_w) は 55000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.85 であった。

[重合物の精製]

得られた重合物を 100 g の THF に溶解させ、得られた溶液を THF 6

00 g と MeOH 400 g との混合溶媒に滴下し、白色の凝固物を析出させた。その後、凝固物を含む溶液をキリヤマ漏斗によりろ過し、析出した白色の凝固物を得た。得られた凝固物の重量平均分子量 (M_w) は 65000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.47 であった。

次いで、得られた凝固物を 100 g の THF に再び溶解させ、得られた溶液を THF 650 g と MeOH 350 g との混合溶媒に再び滴下し、白色の凝固物を再び析出させた。その後、再析出した凝固物を含む溶液をキリヤマ漏斗によりろ過し、ろ液を回収した。そして、ろ液を濃縮乾固し、白色の凝固物 (α -メチルスチレン単位および α -クロロアクリル酸メチル単位を含有する重合体) を得た。得られた重合体について、重量平均分子量、数平均分子量および分子量分布、重合体中の各分子量の成分の割合を実施例 1 と同様にして測定した結果を表 1 に示す。

<ポジ型レジスト組成物の調製>

上述のようにして調製した重合体を用いた以外は実施例 1 と同様にして、ポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして評価を行った。結果を表 1 に示す。

[0043] (比較例 1)

単量体組成物の重合時に使用する重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.01091 g に変更し、重合物の精製を実施することなく、単量体組成物を重合した際にろ過により回収した重合物をそのまま重合体として用いてポジ型レジスト組成物を調製した以外は実施例 1 と同様にして、重合物 (α -メチルスチレン単位および α -クロロアクリル酸メチル単位を含有する重合体) およびポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして測定および評価を行った。結果を表 1 に示す。

[0044] (比較例 2)

<重合体の調製>

[単量体組成物の重合]

重合開始剤としてのアゾビスイソブチロニトリルの量を 0.01091 g

に変更した以外は実施例 1 と同様にして単量体組成物を重合し、重合物を得た。なお、重合物の重量平均分子量 (M_w) は 55000 であり、分子量分布 (M_w/M_n) は 1.85 であった。

[重合物の精製]

得られた重合物を 100 g の THF に溶解させ、得られた溶液を THF 600 g と MeOH 400 g との混合溶媒に滴下し、白色の凝固物を析出させた。その後、凝固物を含む溶液をキリヤマ漏斗によりろ過し、ろ液を回収した。そして、ろ液を濃縮乾固し、白色の凝固物 (α -メチルスチレン単位および α -クロロアクリル酸メチル単位を含有する重合体) を得た。得られた重合体について、重量平均分子量、数平均分子量および分子量分布、重合体中の各分子量の成分の割合を実施例 1 と同様にして測定した結果を表 1 に示す。

<ポジ型レジスト組成物の調製>

上述のようにして調製した重合体を用いた以外は実施例 1 と同様にして、ポジ型レジスト組成物を調製した。そして、実施例 1 と同様にして評価を行った。結果を表 1 に示す。

[0045]

[0046] 表 1 より、分子量が 6 0 0 0 未満の成分の割合が 0. 5 % 以下である実施例 1 ～ 6 の重合体よりなるポジ型レジストは、分子量が 6 0 0 0 未満の成分の割合が 0. 5 % 超の比較例 1 ～ 2 の重合体よりなるポジ型レジストよりも低照射量における減膜率が低いことが分かる。

産業上の利用可能性

[0047] 本発明の重合体によれば、電離放射線等の照射量が少ない状態での減膜率が低いポジ型レジストを提供することができる。

また、本発明のポジ型レジスト組成物によれば、高解像度のパターンを良好に形成することができる。

請求の範囲

- [請求項1] α -メチルスチレン単位と、 α -クロロアクリル酸メチル単位とを含有し、
分子量が6000未満の成分の割合が0.5%以下である、重合体。
- [請求項2] 分子量が10000未満の成分の割合が0.5%以下である、請求項1に記載の重合体。
- [請求項3] 分子量が80000超の成分の割合が15%以上である、請求項1または2に記載の重合体。
- [請求項4] 重量平均分子量（Mw）が55000以上である、請求項1～3の何れかに記載の重合体。
- [請求項5] 請求項1～4の何れかに記載の重合体と、溶剤とを含む、ポジ型レジスト組成物。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/000767

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C08F212/06(2006.01)i, C08F220/22(2006.01)i, G03F7/039(2006.01)i, G03F7/20(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C08F212/06, C08F220/22, G03F7/039, G03F7/20

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996-2016

Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2016 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994-2016

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

CAplus/REGISTRY (STN)

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	WO 1999/062964 A1 (Nippon Zeon Co., Ltd.), 09 December 1999 (09.12.1999), claims; page 9, lines 4 to 17; examples (Family: none)	1-5
X	JP 2002-124448 A (Nippon Zeon Co., Ltd.), 26 April 2002 (26.04.2002), claims; examples (Family: none)	1-5
X	JP 63-137227 A (Fujitsu Ltd.), 09 June 1988 (09.06.1988), claims; page 2, lower left column, lines 11 to 15; examples (Family: none)	1-5

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents:

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search
02 March 2016 (02.03.16)Date of mailing of the international search report
26 April 2016 (26.04.16)Name and mailing address of the ISA/
Japan Patent Office
3-4-3, Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8915, Japan

Authorized officer

Telephone No.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP2016/000767

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 3-132760 A (Fujitsu Ltd.), 06 June 1991 (06.06.1991), claims; page 3, upper right column, lines 1 to 4; examples & US 5403699 A claims; column 6, lines 22 to 33; examples & EP 424182 A2 & DE 69032464 C	1-5
X	T. Yamaguchi et al., Influence of molecular weight of resist polymers on surface roughness and line-edge roughness, J. Vac. Sci. Technol. B, 2004, 22(6), p.2604-2610	1-5
X	T. Yamaguchi et al., Molecular weight effect on line-edge roughness, Proceedings of SPIE, 2003, 5039, p.1212-1219	1-5
X	M. Otani et al., Improvement of polymer type EB resist sensitivity and line edge roughness, Proceedings of SPIE, 2011, 8081, p.808107/1- 808107/8	1-5

A. 発明の属する分野の分類（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. C08F212/06(2006.01)i, C08F220/22(2006.01)i, G03F7/039(2006.01)i, G03F7/20(2006.01)i

B. 調査を行った分野

調査を行った最小限資料（国際特許分類（IPC））

Int.Cl. C08F212/06, C08F220/22, G03F7/039, G03F7/20

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報	1922-1996年
日本国公開実用新案公報	1971-2016年
日本国実用新案登録公報	1996-2016年
日本国登録実用新案公報	1994-2016年

国際調査で使用した電子データベース（データベースの名称、調査に使用した用語）

CAplus/REGISTRY (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	W0 1999/062964 A1（日本ゼオン株式会社）1999.12.09, 特許請求の範囲、第9頁第4行～第17行、実施例 （ファミリーなし）	1-5
X	JP 2002-124448 A（日本ゼオン株式会社）2002.04.26, 特許請求の範囲、実施例 （ファミリーなし）	1-5

☒ C欄の続きにも文献が列挙されている。

☐ パテントファミリーに関する別紙を参照。

* 引用文献のカテゴリー

「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの
「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日以後に公表されたもの
「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する文献（理由を付す）
「O」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

の日の後に公表された文献

「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論の理解のために引用するもの
「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以上の文献との、当業者にとって自明である組合せによって進歩性がないと考えられるもの
「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

02.03.2016

国際調査報告の発送日

26.04.2016

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁（ISA/J P）

郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官（権限のある職員）

安田 周史

4 J

3445

電話番号 03-3581-1101 内線 3457

C (続き) . 関連すると認められる文献		
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求項の番号
X	JP 63-137227 A (富士通株式会社) 1988.06.09, 特許請求の範囲、第2頁左下欄第11行～第15行、実施例 (ファミリーなし)	1-5
X	JP 3-132760 A (富士通株式会社) 1991.06.06, 特許請求の範囲、第3頁右上欄第1行～第4行、実施例 & US 5403699 A, claims、column 6 l.22-33、examples & EP 424182 A2 & DE 69032464 C	1-5
X	T. Yamaguchi et al., Influence of molecular weight of resist polymers on surface roughness and line-edge roughness, J. Vac. Sci. Technol. B, 2004, 22(6), p.2604-2610	1-5
X	T. Yamaguchi et al., Molecular weight effect on line-edge roughness, Proceedings of SPIE, 2003, 5039, p.1212-1219	1-5
X	M. Otani et al., Improvement of polymer type EB resist sensitivity and line edge roughness, Proceedings of SPIE, 2011, 8081, p.808107/1-808107/8	1-5